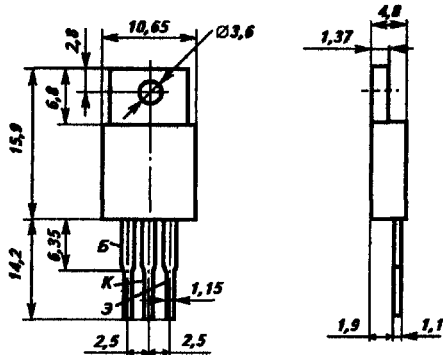


□ КТ8116А, КТ8116Б, КТ8116В



КТ8116 (А-В)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* составные усилительные. Предназначены для применения в усилительных и переключаемых схемах, в преобразователях напряжения. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 3 г.

Электрические параметры

- Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 3$ В, $I_{\text{б}} = 0,5$ А, не менее
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 3$ В, $I_{\text{б}} = 0,1$ А, не менее
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{\text{к}} = 3$ А, $I_{\text{б}} = 0,12$ А, не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:	
КТ8116А	100 В
КТ8116Б	80 В
КТ8116В	60 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{\text{бэ}} = 1$ кОм:	
КТ8116А	100 В
КТ8116Б	80 В
КТ8116В	60 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 В
Постоянный ток коллектора	8 А
Импульсный ток коллектора	16 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_{\text{к}} = +25$ °С	65 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-45 °С... $T_{\text{к}} = +100$ °С